

KI669,670

ギャップ幅広・防塵タイプ

外形寸法 (単位 =mm)

概要

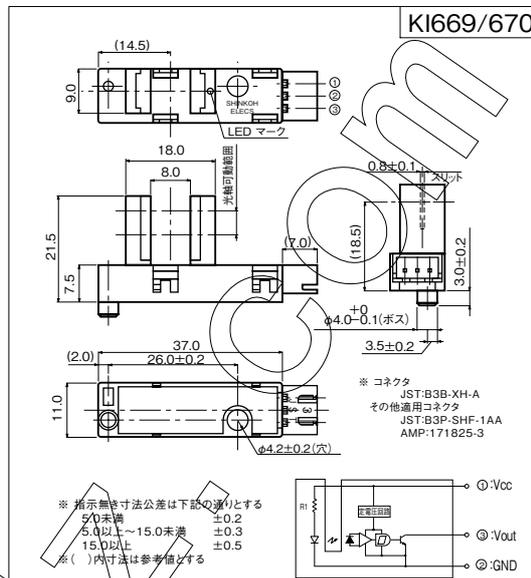
KI669,KI670 は、赤外発光ダイオードと受光素子にフォトIC (デジタル出力) を組合せ、検出用スリット部を防塵タイプにした透過型フォトセンサです。

特長

- アンプ内蔵、オープンコレクタ出力タイプ
- 可視光カット樹脂使用の防塵構造
- 検出ギャップが8mm、深さ14mmで大きな物でも検出可能
- 光軸を4mmの範囲で設定可能
- その他シリーズ
プルアップ抵抗内蔵タイプ…… 入光時 Low :KI659
入光時 High:KI660

用途

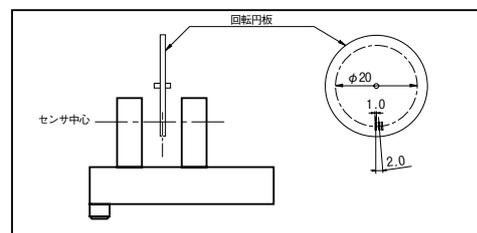
- カード機器、両替機の物体通過検出
- 自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
- OA機器、その他



形式	動作モード
KI669	入光時 Low
KI670	入光時 High

最大定格 [Ta=25°C]

項目	記号	定格値	単位
電源電圧	V _{CC}	6	V
ローレベル出力電流	I _{OL}	50	mA
動作温度	T _{opr}	-20 ~ +75	°C
保存温度	T _{stg}	-40 ~ +80	°C



注：上図のスリット円板を回転させたときの値である。出力がDCにならないこと。

電気的光学的特性 [V_{CC}=5V, Ta=25°C]

項目	記号	測定条件	min.	typ.	max.	単位
動作電源電圧	V _{CC}		4.5	5.0	5.5	V
ローレベル供給電流	I _{CLL}	KI669 入光時	—	—	25	mA
		KI670 遮光時	—	—	25	
ハイレベル供給電流	I _{CHH}	KI669 遮光時	—	—	25	mA
		KI670 入光時	—	—	25	
ローレベル出力電圧	V _{OL}	KI669 入光時, I _{OL} =16mA	—	—	0.4	V
		KI670 遮光時, I _{OL} =16mA	—	—	0.4	
ハイレベル出力電圧	V _{OH}	KI669 遮光時, R _L =47kΩ	V _{CC} × 0.9	—	—	V
		KI670 入光時, R _L =47kΩ	V _{CC} × 0.9	—	—	
応答周波数	f		3000	—	—	Hz
応答時間	上昇	t _r	—	0.86	—	μ sec
	下降	t _f	—	0.03	—	

